

СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте

по диссертации Паршина Анатолия Сергеевича «Спектроскопия неупруго отраженных электронов твердотельных наноструктур элементарных полупроводников, магнитных металлов и их соединений» по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» на соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук

Фамилия, имя, отчество	Коханенко Андрей Павлович
Ученая степень, наименование отрасли науки, шифр и наименование научной специальности, по которой защищена диссертация	Доктор физико-математических наук Диссертация на соискание ученой степени д.ф.-м.н. защищена по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков.
Должность	Профессор кафедры квантовой электроники и фотоники радиофизического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета
Наименование подразделения	Радиофизический факультет Национального исследовательского Томского государственного университета
Полное и сокращенное наименование организации места работы в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», НИ ТГУ

Публикации в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

1. Voitsekhovskii A.V., Gorn D.I., Nesmelov S.N., Kokhanenko A.P. Energy-band diagrams and capacity-voltage characteristics of $CdxHg_{1-x}Te$ -based variband structures calculated with taking into account dependence of electron affinity on a composition // *Opto - Electronics Review*. 2010. Vol. 18, Is. 3. P. 241-245.
2. Lozovoy K.A., Voitsekhovskii A.V., Kokhanenko A.P., Satdarov V.G. Comparative analysis of pyramidal and wedge-like quantum dots formation kinetics in Ge/Si(001) system // *Surface Science*. 2014, Vol. 619, Is. 1. P. 1-4.
3. Kirill A. Lozovoy, A.V. Voitsekhovskii, Andrey P. Kokhanenko and Vadim G. Satdarov. Photodetectors and solar cells with Ge/Si quantum dots parameters dependence on growth conditions // *International Journal of Nanotechnology*. 2015, Vol. 12, Is. 3/4. P. 209-217.
4. Vadim G. Satdarov, A.V. Voitsekhovskii, Andrey P. Kokhanenko and Kirill A. Lozovoy. Investigation of Ge/Si quantum dot structures using the methods of admittance spectroscopy // *International Journal of Nanotechnology*. 2015, Vol. 12, Is. 3/4. P. 285-296.
5. Kirill A. Lozovoy, Andrey P. Kokhanenko, A.V. Voitsekhovskii. Influence of Edge Energy on Modeling the Growth Kinetics of Quantum Dots // *Crystal Growth & Design*. 2015, Vol. 15, Is. 3. P. 1055-1059.
6. Войцеховский А.В., Коханенко А.П., Лозовой К.А., Турапин А.М., Романов И.С. Фоточувствительные структуры на основе наногетероструктур Si/Ge для оптических систем передачи информации// *Успехи прикладной физики* Т. 1. – № 3. – С. 338-343.
7. Войцеховский А.В., Сатдаров В.Г., Коханенко А.П., Калин Е.А., Никифоров А.И., Дзядух С.М. Исследование характеристик наногетероструктур Si/Ge с квантовыми

- точками методом адмиттансной спектроскопии Изв. вузов. Физика – 2013. – Т. 56. – № 9/2. – С. 5-7.
8. Пищагин А.А, Войцеховский А.В., Коханенко А.П., Сатдаров В.Г. Моделирование кремниевого р–i–п фотодиода со встроенными слоями квантовых точек германия с помощью «TCAD Sentaurus» Изв. вузов. Физика – 2013. – Т. 56. – № 9/2. – С. 131-133.
 9. Войцеховский А.В., Григорьев Д.В., Коротаев А.Г., Коханенко А.П., Петерс А.С., Тарасенко В.Ф., Шулепов М.А. Влияние комплексного воздействия электронного пучка пикосекундной длительности и объёмного разряда в воздухе атмосферного давления на электрофизические свойства эпитаксиального материала CdHgTe Изв. вузов. Физика – 2013. – Т. 56. – № 9/2. – С. 137-139.
 10. А. В. Войцеховский, А. П. Коханенко, К. А. Лозовой. Моделирование кинетики формирования клиновидных квантовых точек германия на кремнии // Известия РАН. Серия физическая, 2014, том 78, № 10. - С. 1312–1316. (ISSN 0367-6765)
 11. Е.А. Емельянов, А.П. Коханенко, Д.С. Абрамкин, О.П. Пчеляков, М.А. Путято, Б.Р. Семагин, В.В. Преображенский, А.П. Василенко, Д.Ф. Феклин, Zhiguan Niu, Haiqiao Ni Квантовые ямы InGaAs/GaAs, выращенные методом МЛЭ на искусственных подложках GaAs/Si(001) //Физика. Известия высших учебных заведений. 2014, Т. 57, № 3. –С.68-72. (ISSN 0021-3411)
 12. А.В. Войцеховский, Н.А. Кульчицкий, А.А. Мельников, С.Н. Несмелов, А.П. Коханенко, К.А. Лозовой. Особенности создания кремний-германиевых наноструктур с квантовыми точками для перспективных приборов микро- и оптоэлектроники // Наноинженерия, 2014. № 6. – С. 3-20. ISSN 2223-4586
 13. А. В. Войцеховский, Н. А. Кульчицкий, А. А. Мельников, С. Н. Несмелов, А. П. Коханенко, К. А. Лозовой. Технология создания структур с квантовыми точками Ge/Si молекулярно-лучевой эпитаксией // Нано- и микросистемная техника. – 2014. – № 9. – С. 20-31. ISSN 1813-8586
 14. А. В. Войцеховский, Н.А. Кульчицкий, А.А. Мельников, С. Н. Несмелов, А. П. Коханенко, К.А. Лозовой. Современные методы создания структур с квантовыми точками Ge/Si // Нано- и микросистемная техника. – 2014. – № 10. – С. 18-26. ISSN 1813-8586